



本記事は, 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 秀でた利用成果について紹介するものです.

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム 令和元年度秀でた利用成果 BiFe_{1-x}Co_xO₃ 薄膜のスピン構造変化 ~電場による磁化の反転に成功,次世代低消費電力磁気メモリ 実現の道拓く~

東京工業大学 東 正樹,重松 圭 九州大学 北條 元 名古屋工業大学 壬生 攻



(左) 壬生 教授とメスバウアー分光測定装置,(中)東 教授,重松 助教とレーザーアブレーション成膜装置 (右) 北條 准教授と透過型電子顕微鏡



スマートフォンの普及やビッグデータなどによる情報 処理量の爆発的な増大に伴う,情報通信機器の消費電力 が問題になるなかで,低消費電力・高記録密度・不揮 発性の次世代メモリデバイスへの要求が高まっている. HDDや MRAM (Magnetic Random Access Memory)等 の磁気メモリは温度安定性に優れるが,書き込みのため にコイルに電流を流して磁場を発生する必要があるため, 消費電力が大きくなってしまうという欠点がある.電流 で磁壁を移動するレーストラックメモリなどのスピント ロニクスデバイスも,スピン偏極した電流によって書き 込みを行っている.こうした観点から注目されるのが, 強磁性と強誘電性を併せ持つマルチフェロイック物質で ある.

強磁性と強誘電性の相関が十分に強く,電気分極反転 に伴って磁化を反転することが可能ならば,電場書き込 み磁気読み出し(電圧駆動)の超低消費電力磁気メモリ を実現できると期待される. これはマルチフェロイクス 材料研究の一つの大きな目標だが, これまで室温で明確 に示した例はなかった.

BiFeO₃は、巨大な自発分極を持つ強誘電体である事に 加えて、Fe³⁺に由来する磁性が共存することから注目を 集め,世界中で広く研究されている [1]. Bi³⁺の最外殻電 子(6s²電子)が孤立電子対と呼ばれる立体障害となっ て、周囲の陰イオンと反発するため、結晶格子内の陽イ オンと陰イオンの重心がずれて, 電気分極を生じてい る(強誘電性).一方,Fe³⁺が持つスピン 5/2の磁気モー メントは, 隣り合ったスピンが反対を向く反強磁性秩 序を持っている.反強磁性体でも、ジャロシンスキー守 谷(DM)相互作用により、隣り合うスピンがわずかに傾 くことで, 弱強磁性と呼ばれる自発磁化を持つ場合があ る.しかし、BiFeO3ではこうして生まれた局所的な磁化 が、62nmの周期で方向を一回りさせてしまう、サイク ロイドと呼ばれる変調構造を持つため、全体としては磁 気モーメントが互いにうち消しあってしまい、自発磁化 は発現しない(図1(a)). 我々は,非鉛圧電体の候補物



反強磁性(サイクロイド)

弱強磁性

図1 (a) BiFeO₃と(b) BFCOの磁気構造の模式図. BiFeO₃は反強磁性体であるため, スピンの磁化は打ち消し合い自発磁化は現れない. 一方, BFCOではスピンが傾斜しているため,磁化は打ち消し合わずに自発磁化が現れる.

質として,BiFeO₃とBiCoO₃の固溶体であるBiFe_{1*}Co_xO₃ (BFCO)の研究をしていたのだが, $x \leq 0.2$ ではBiFeO₃型 の結晶構造を保ったまま,室温で $0.03\mu_B$ 程度の自発磁化 を持つ弱強磁性を生じる事に気がついた [2].この起源を 解明するため,筆者の大学の先輩で,ナノテクノロジー プラットフォームでメスバウアー分光の支援を行ってい る,名古屋工業大学の壬生教授に相談し,共同研究を開 始した.その結果,低温で存在するサイクロイド変調が, 昇温によって消失するために,DM相互作用による弱強磁 性を生じていることを明らかにする事が出来た [3].さら に,BFCOの薄膜試料を用い,室温で電場印加による磁化 反転を明確に観察することに成功した [4].



BiFe_{1-x}Co_xO₃ (x=0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2) の焼結体 試料は,キュービックアンビル型高圧発生装置を用い, 3GPa 900℃の条件で合成した. 図2 (a) に室温で測定 した磁化曲線を示す. x = 0.1, 0.15, 0.2 では, 組成に よらない約 0.03µ_B の自発磁化が発現していることがわか る.また,図2 (b) のように,低温で磁化が減少してお り,弱強磁性は低温にすると消失してしまうことがわかっ た.これは,高温で強磁性が消失する通常の磁性体とは 逆の振る舞いである.この起源を明らかにするため,⁵⁷Fe エンリッチした試料を用意し,メスバウアー分光を行っ た [3].

図3(a)はBiFe_{0.9}Co_{0.1}O₃のメスバウアースペクトルの



図 2 BiFe_{1-x}Co_xO₃ (*x*=0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)の(a)室温での 磁化曲線と,(b)磁化率温度変化.*x*=0.1, 0.15, 0.2 は室温で弱 強磁性を示すが,低温にすると磁化が消失していることがわかる. [3]より許諾を得て転載.

温度依存である.78Kでは、スペクトルは左右非対称で、 フィッティングには少なくとも2つの成分が必要であっ た. これは、BiFeO3 で見つかっているスピンサイクロイ ド変調の特徴で、電場勾配の主軸に対し、スピンの方向 が一定ではなく、場所によって回転するために生じてい る. 解析を容易にするため、スピンが電場勾配に平行な 成分と垂直な成分の2成分でのフィッティングを行った 結果が実線である.両者の成分はほぼ 1:1 であった.一 方で、室温のスペクトルは左右対称であり、スピンが電 場勾配に垂直な成分のみでフィット出来た. 電場勾配は 自発分極に平行なので、BFCOは室温で、電気分極と垂 直にスピンが配列した, コリニアスピン構造を持つ事が わかる.図1(b)に示す様に、この場合、DM相互作用 のために、電気分極とスピンの両方に直交する方向にス ピン傾斜が生じ、自発磁化が生まれることが期待される. これが磁化測定で観測された弱強磁性の起源である. さ らに、中間温度のメスバウアースペクトルを詳細に解析 することで、低温のサイクロイド相から室温のコリニア 相への転移は、両者が分率を変えながら2相共存する、 1次転移である事がわかった.図3(b)に示す様に、メ スバウアースペクトルの解析で見積もったコリニア相分 率の温度変化は、磁化率の変化と合致している、また、 薄膜試料についても同様の結果を得ている [5].

BFCOでは、サイクロイド変調の消失に伴い、DM 相 互作用により、弱強磁性の自発磁化が発現する事がわ かった. 電気分極と磁化の方向が直交しているため, 分 極の反転に伴って磁化の方向も変化することが期待され る. これを検証するために、パルスレーザー蒸着法で、 GdScO₃ 基板上に薄膜試料を作成した.図4は得られた薄 膜試料のメスバウアー分光測定結果である. 比較のため の BiFeO₃ではスペクトルが左右非対称で、スピンサイク ロイド相であるのに対し、BFCO では左右対称のスペク トルが得られており、コリニア相になっていることがわ かる [4]. さらに詳しく解析すると、スピンは面直方向か ら 63°傾いていることがわかった. BiFeO。は菱面体晶の 結晶構造を持っており、図1に表した電気分極の方向は, 擬立方表記の [111] 方向に対応する. スピンは電気分極 に直交しており、さらに面直方向から 63°傾いているの で.図4(d)の4つの方向のいずれかを向いていること がわかる. これは, [111] 方向から見た際の, 60°ずつ離 れた6つの方向の内の4つである.外部からの電圧印加 で電気分極の面外方向を反転した際,スピンの方向が4 つの内の別の方向に変化するならば、磁化の面外成分も 反転する事が期待される. そこで,圧電応答顕微鏡 (PFM) と磁気力顕微鏡(MFM)を用いて, 強誘電ドメイン, 強 磁性ドメインの観測を行った.



図5は電気分極を反転する前(上)と反転した後(下)の, BFCO薄膜の室温における PFM 像(左)と, MFM 像(右) である.それぞれ,強誘電ドメイン構造と磁気ドメイン 構造に対応している.また,色は,それぞれ電気分極の 薄膜面内成分および磁化の薄膜面外方向の成分を表して いる.上左図の強誘電ドメインが寒色であることは,電



図4 薄膜試料のメスバウアー分光測定結果.(a) GdScO₃ 基板上に作成した BiFeO₃ と,(b) BiFe₀,CO₀,O₃ の室温でのメスバウアースペクトル.(c) 電気分極 に直交している,(d) 面直方向から63°傾いている,という条件から決定された (e) スピン(L) の方向.(f)[111]方向から見た BFCO 薄膜のスピンの方向.(g) 分極反転前,(h) 反転後のスピンと自発磁化(M)の方向.[4]より許諾を得て転載.



図5 電気分極反転前(上)と電気分極反転後(下)のBFCO薄膜の室温 における圧電応答顕微鏡像(左)と磁気力応答顕微鏡像(右)[4]より許 諾を得て転載.

気分極の面外成分が紙面の奥方向を向いていることに対応する.また,面内の分極方向の違いを反映した,ストライプ状のドメイン構造を持っていることがわかる.磁気ドメイン像も同じストライプ構造を持っており,強誘電ドメインと強磁性ドメインの間に,メスバウアー分光で示唆された相関があることがわかる.ここで,PFMのカンチレバーを掃引することで面外方向に電圧を印加し,電気分極の面外方向を反転する.下左図では,電気分極の方向が紙面奥向きから手前向きに反転したことを反映して,強誘電ドメインの色が暖色に変化している.また,右上下を比較すると,電気分極の反転により,磁化の面外成分が反転していることがわかる.これはまさに電場印加による磁化反転であり,電圧駆動マルチフェロイックメモリの実現に大きく近づく成果である [4].



メスバウアー分光測定により,BFCOにおける弱強磁 性の起源が,サイクロイドスピン構造からがコリニア構 造への変化に起因することを明らかにすることができた. さらに,薄膜試料において,電気分極と磁化の方向の関 係を解明したことが,新しい磁気メモリ実現のための鍵 といわれてきた,室温での電場による磁化反転の実現に 繋がった.しかしながら,電気分極反転に伴ってスピン の方向が変化するメカニズムは未解明であるし,メモリ デバイス化のためには微細加工によるシングルドメイン 化が不可欠である.引き続きナノテクノロジープラット フォームの支援を受けながら,研究を続けたい.



本研究では、文部科学省ナノテクノロジープラット フォーム事業(名古屋工業大学スマートマテリアル創成 支援)の支援を受けて行われた.メスバウアー分光は放 射性同位体を用いる事から,実施可能な機関が限られて おり,しかも薄膜試料の温度変化はさらに困難である. 貴重な装置とノウハウを駆使して,長時間にわたる測定 を引き受けていただけたことは幸運であった.ナノテク ノロジープラットフォームは,このようなニーズに応え てくれる大変貴重な仕組みである.

上記の成果は,東京工業大学科学技術創成研究院の清水啓佑博士研究員,東北大学多元物質科学研究所の山本 孟助教との共同研究である.また,神奈川県立産業技術 研究所戦略的研究シーズ育成事業,ならびに有望シーズ 展開事業の支援を受けて実施された.



- H. Hojo, K. Oka, K. Shimizu, H. Yamamoto, R. Kawabe, and M. Azuma, Advanced Materials, 30, 1705665 (2018).
- [2] I. Sosnowska, M. Azuma, R. Przeniosło, D. Wardecki, W. Chen, K. Oka, and Y. Shimakawa, Inorganic Chemistry, 52, 13269 (2013).
- [3] H. Yamamoto, T. Kihara, K. Oka, M. Tokunaga, K. Mibu, and M. Azuma, Journal of the Physical Society of Japan, 85, 064704 (2016).
- [4] K. Shimizu, R. Kawabe, H. Hojo, H. Shimizu, H. Yamamoto, M. Katsumata, K. Shigematsu, K. Mibu, Y. Kumagai, F. Oba, and M. Azuma, Nano Letters, 19, 1767 (2019).
- [5] H. Hojo, R. Kawabe, K. Shimizu, H. Yamamoto, K. Mibu, K. Samanta, T. Saha-Dasgupta, and M. Azuma, Advanced Materials 29, 1603131 (2017).

(東京工業大学 東正樹)

